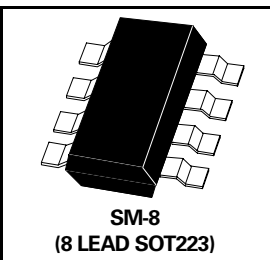
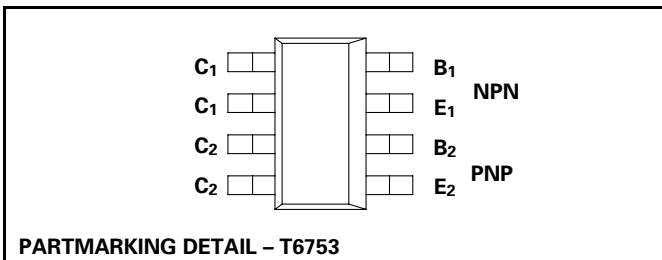


SM-8 COMPLEMENTARY MEDIUM POWER TRANSISTORS

ZDT6753

ISSUE 1 – JANUARY 1996



ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS.

PARAMETER	SYMBOL	NPN	PNP	UNIT
Collector-Base Voltage	V_{CBO}	120	-120	V
Collector-Emitter Voltage	V_{CEO}	100	-100	V
Emitter-Base Voltage	V_{EBO}	5	-5	V
Peak Pulse Current	I_{CM}	6	-6	A
Continuous Collector Current	I_C	2	-2	A
Operating and Storage Temperature Range	$T_j; T_{stg}$	-55 to +150		°C

THERMAL CHARACTERISTICS

PARAMETER	SYMBOL	VALUE	UNIT
Total Power Dissipation at $T_{amb} = 25^\circ\text{C}^*$ Any single die "on" Both die "on" equally	P_{tot}	2.25 2.75	W W
Derate above 25°C^* Any single die "on" Both die "on" equally		18 22	mW/°C mW/°C
Thermal Resistance - Junction to Ambient* Any single die "on" Both die "on" equally		55.6 45.5	°C/W °C/W

* The power which can be dissipated assuming the device is mounted in a typical manner on a PCB with copper equal to 2 inches square.

ZDT6753

NPN TRANSISTOR ELECTRICAL CHARACTERISTICS (at $T_{amb} = 25^{\circ}\text{C}$).

PARAMETER	SYMBOL	MIN.	TYP.	MAX.	UNIT	CONDITIONS.
Collector-Base Breakdown Voltage	$V_{(BR)CBO}$	120			V	$I_C=100\mu\text{A}, I_E=0$
Collector-Emitter Breakdown Voltage	$V_{(BR)CEO}$	100			V	$I_C=10\text{mA}, I_B=0^*$
Emitter-Base Breakdown Voltage	$V_{(BR)EBO}$	5			V	$I_E=100\mu\text{A}, I_C=0$
Collector Cutoff Current	I_{CBO}			0.1 10	μA μA	$V_{CB}=100\text{V}$ $V_{CB}=100\text{V}, T_{amb}=100^{\circ}\text{C}$
Emitter Cutoff Current	I_{EBO}			0.1	μA	$V_{EB}=4\text{V}, I_C=0$
Collector-Emitter Saturation Voltage	$V_{CE(sat)}$		0.13 0.23	0.3 0.5	V	$I_C=1\text{A}, I_B=100\text{mA}^*$ $I_C=2\text{A}, I_B=200\text{mA}^*$
Base-Emitter Saturation Voltage	$V_{BE(sat)}$		0.9	1.25	V	$I_C=1\text{A}, I_B=100\text{mA}^*$
Base-Emitter Turn-On Voltage	$V_{BE(on)}$		0.8	1	V	$I_C=1\text{A}, V_{CE}=2\text{V}^*$
Static Forward Current Transfer Ratio	h_{FE}	70 100 55 25	200 200 110 55	300		$I_C=50\text{mA}, V_{CE}=2\text{V}$ $I_C=500\text{mA}, V_{CE}=2\text{V}^*$ $I_C=1\text{A}, V_{CE}=2\text{V}^*$ $I_C=2\text{A}, V_{CE}=2\text{V}^*$
Transition Frequency	f_T	140	175		MHz	$I_C=100\text{mA}, V_{CE}=5\text{V}$ $f=100\text{MHz}$
Output Capacitance	C_{obo}			30	pF	$V_{CB}=10\text{V}, f=1\text{MHz}$
Switching Times	t_{on}		80		ns	$I_C=500\text{mA}, V_{CE}=10\text{V}$ $I_{B1}=I_{B2}=50\text{mA}$
	t_{off}		1200		ns	

*Measured under pulsed conditions. Pulse width=300 μs . Duty cycle $\leq 2\%$
For typical characteristics graphs see FZT653 datasheet.

ZDT6753

PNP TRANSISTOR ELECTRICAL CHARACTERISTICS (at $T_{amb} = 25^{\circ}\text{C}$ unless otherwise stated).

PARAMETER	SYMBOL	MIN.	TYP.	MAX.	UNIT	CONDITIONS.
Collector-Base Breakdown Voltage	$V_{(BR)CBO}$	-120			V	$I_C = -100\mu\text{A}$
Collector-Emitter Breakdown Voltage	$V_{CEO(SUS)}$	-100			V	$I_C = -10\text{mA}^*$
Emitter-Base Breakdown Voltage	$V_{(BR)EBO}$	-5			V	$I_E = -100\mu\text{A}$
Collector Cutoff Current	I_{CBO}			-0.1 -10	μA μA	$V_{CB} = -100\text{V}$ $V_{CB} = -100\text{V}$, $T_{amb} = 100^{\circ}\text{C}$
Emitter Cutoff Current	I_{EBO}			-0.1	μA	$V_{EB} = -4\text{V}$
Collector-Emitter Saturation Voltage	$V_{CE(sat)}$		-0.17 -0.30	-0.3 -0.5	V V	$I_C = -1\text{A}$, $I_B = -100\text{mA}^*$ $I_C = -2\text{A}$, $I_B = -200\text{mA}^*$
Base-Emitter Saturation Voltage	$V_{BE(sat)}$		-0.90	-1.25	V	$I_C = -1\text{A}$, $I_B = -100\text{mA}^*$
Base-Emitter Turn-On Voltage	$V_{BE(on)}$		-0.8	-1.0	V	$I_C = -1\text{A}$, $V_{CE} = -2\text{V}^*$
Static Forward Current Transfer Ratio	h_{FE}	70 100 55 25	200 200 170 55	300		$I_C = -50\text{mA}$, $V_{CE} = -2\text{V}$ $I_C = -500\text{mA}$, $V_{CE} = -2\text{V}^*$ $I_C = -1\text{A}$, $V_{CE} = 2\text{V}^*$ $I_C = -2\text{A}$, $V_{CE} = -2\text{V}^*$
Transition Frequency	f_T	100	140		MHz	$I_C = -100\text{mA}$, $V_{CE} = 5\text{V}$ $f = 100\text{MHz}$
Output Capacitance	C_{obo}			30	pF	$V_{CE} = -10\text{V}$, $f = 1\text{MHz}$
Switching Times	t_{on}		40		ns	$I_C = -500\text{mA}$, $V_{CC} = -10\text{V}$ $I_{B1} = I_{B2} = 50\text{mA}$
	t_{off}		600		ns	

*Measured under pulsed conditions. Pulse width=300 μs . Duty cycle $\leq 2\%$
For typical characteristics graphs see FZT753 datasheet.

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru